# 氧化铝对无压烧结氮氧化硅微观组织的影响

李龙涛1,陈德庆2,李 光2,银锐明3\*,肖毅成4,高 震4,吴镇宏5

<sup>1</sup>湘潭大学材料科学与工程学院,湖南 湘潭
<sup>2</sup>江西氮化硅新材料有限公司,江西 南城
<sup>3</sup>湖南工业大学醴陵陶瓷学院,湖南 醴陵
<sup>4</sup>湖南工业大学材料与先进制造学院,湖南 株洲
<sup>5</sup>东莞创基资本,广东 东莞

收稿日期: 2024年8月6日; 录用日期: 2024年9月6日; 发布日期: 2024年9月13日

## 摘要

首先以单质硅和二氧化硅在氮气氛围下,采用流延法制备出质量分数ω≥90%的氮氧化硅,通过凝胶注 模方式制备生胚,分别于50℃、80℃、120℃、160℃四个阶段进行脱水和初步脱脂,最终在1450℃氮 气氛围常压烧结下进行氮氧化硅烧结实验,研究不同含量下的氧化铝(0wt.%,10 wt.%,15 wt.%,20 wt.%)烧结助剂对氮氧化硅陶瓷微观形貌和相组成的影响,后续选出两组氧化铝最优添加量进行温度梯 度(1350℃~1480℃)烧结。结果表明氧化铝的最佳添加量为15 wt.%时,对氮氧化硅陶瓷性能提升最为 明显,最佳烧结温度在1450℃,能避免氮氧化硅分解的同时,最大限度提升其各项性能。

### 关键词

Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, 凝胶注模

## The Effect of Alumina on the Microstructure of Pressureless Sintered Nitrogen Oxide Silicon

Longtao Li<sup>1</sup>, Deqing Chen<sup>2</sup>, Guang Li<sup>2</sup>, Ruiming Yin<sup>3\*</sup>, Yicheng Xiao<sup>4</sup>, Zhen Gao<sup>4</sup>, Zhenhong Wu<sup>5</sup>

<sup>1</sup>School of Materials Science and Engineering, Xiangtan University, Xiangtan Hunan
 <sup>2</sup>Jiangxi Silicon Nitride New Materials, Nancheng Jiangxi
 <sup>3</sup>Liling Ceramic College, Hunan University of Technology, Liling Hunan
 <sup>4</sup>School of Materials and Advanced Manufacturing, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan
 <sup>5</sup>Dongguan Chuangji Capital, Dongguan Guangdong

Received: Aug. 6<sup>th</sup>, 2024; accepted: Sep. 6<sup>th</sup>, 2024; published: Sep. 13<sup>th</sup>, 2024

\*通讯作者。

**文章引用:** 李龙涛, 陈德庆, 李光, 银锐明, 肖毅成, 高震, 吴镇宏. 氧化铝对无压烧结氮氧化硅微观组织的影响[J]. 材料科学, 2024, 14(9): 1292-1298. DOI: 10.12677/ms.2024.149143

#### Abstract

Initially, silicon nitride ceramics with a mass fraction of  $\omega \ge 90\%$  were prepared by the slip casting method using elemental silicon and silica under a nitrogen atmosphere. Green bodies were formed using gel-casting, followed by dehydration and preliminary degreasing at four stages: 50°C, 80°C, 120°C, and 160°C. The final sintering experiments were conducted under atmospheric pressure in a nitrogen atmosphere at 1450°C. The effects of various alumina sintering aids (0 wt.%, 10 wt.%, 15 wt.%, 20 wt.%) on the microstructure and phase composition of the silicon nitride ceramics were studied. Subsequently, two optimal alumina additive amounts were selected for temperature gradient sintering from 1350°C to 1480°C. The results indicated that the most significant improvement in the properties of silicon nitride ceramics was achieved with 15 wt.% alumina, with the optimal sintering temperature being 1450°C, which avoided the decomposition of silicon nitride while maximally enhancing its properties.

## **Keywords**

Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, Mechanical Performance

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

CC ① Open Access

## 1. 引言

Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 作为一种先进陶瓷材料[1] [2],具有出色的机械性能和热性能而广泛应用于航空航天材料,但因为具有较高的介电常数,因此作为透波材料[3]往往不太理想。Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 作为 Si-N-O 体系中唯一稳定的化合物,凭借其性能与 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 类似,因此受到国内外广泛的关注[4] [5]。Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 陶瓷相比于 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>陶瓷具有更低的介电常数( $\varepsilon < 4.31$ , tan $\delta < 4.9 \times 10^{-3}$ ),更低的体积密度(2.81 g·cm<sup>-3</sup>),同时具有良好的抗热震性、较高的机械性能和抗腐蚀性能[6] [7]。但 Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 具有热分解性质[8]-[10],通常在高温环境下分解为 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>和 SiO<sub>2</sub>,直接通过 Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 粉末制备的样品会在 1200℃开始分解,1550℃分解变得显著,导致难以烧结致密化,通常是采用等离子烧结和热压烧结等手段[11]-[13],通过高压氛围抑制其分解。而本文以流延法工业制备的 Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 粉末( $\omega \ge 90$ %)为原料,添加 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>和 Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>作为烧结助剂的方法,在常压烧结下,通过降低烧结温度减少氮氧化硅分解的同时提高了其致密度。

## 2. 实验

实验采用流延法制备的 Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 粉末( $\omega \ge 90\%$ )为原料。在 Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 中加入 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ( $\omega \ge 99\%$ )、Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ( $\omega \ge 99\%$ ),样品配料组分质量比 w 如表 1 所示。

	× xx	
对比组	烧结助剂	保温时间
试样 S0	$0 \ wt.\% \ Al_2O_3 + 3 \ wt.\% \ Y_2O_3$	3 h
试样 S1	$10 \ wt.\% \ Al_2O_3 + 3 \ wt.\% \ Y_2O_3$	3 h

Table 1. Sample preparation parameters 表 1. 样品制备参数

续表		
试样 S2	$15 \text{ wt.\% Al}_2O_3 + 3 \text{ wt.\%} Y_2O_3$	3 h
试样 S3	$20 \ wt.\% \ Al_2O_3 + 3 \ wt.\% \ Y_2O_3$	3 h

将称量好的原料与氮化硅球磨石和去离子水按质量比 1:3:2 混合球磨 4 小时。球磨后将浆料放入干燥 箱于 70℃烘 8 小时,过 80 目筛,与体积比为 25:5:1 溶剂(聚乙二醇 400, PEG400)、单体(甲基丙烯酸羟 乙酯,HEMA)、交联剂(三羟甲基丙烷三丙烯酸酯,TMPTA)预混液搅拌 10 分钟,得到体积比为 50%固 相浆料。加入体积比为 3%引发剂(过氧化苯甲酰,BPO)和塑化剂(N,N-二甲基乙酰胺,DMA)后,将所得 料浆注入长宽高分别为 40 mm, 30 mm 和 15 mm 的模具中。注模后 30℃干燥脱模,再分阶段干燥直至室 温。烧结过程为:在氮气 0.3 L/min 保护氛围下,以 2℃/min 至 500℃保温 30 分钟,7℃/min 至 1000℃保 温 10 分钟,5℃/min 至设定温度(1350℃~1480℃)保温 180 分钟,以 5℃/min 降温至 600℃后,随炉冷却 至室温,获得陶瓷样品,图1为流程制备图。



Figure 1. Process preparation diagram 图 1. 流程制备图

本研究采用 X 射线衍射仪(UItima-IV, Rigaku)对所制备的样品进行物相分析,设备管电压为 40 kV, 管电流为 35 mA,采用 Cu 靶 K α射线,以 0.02°的扫描步长、5°/min 的扫描速度对试样 15°~85°范围进行 扫描。使用 ZEISS SUPRA 55 扫描电镜进行观察和分析微观形貌与元素组成。样品的热重分析使用德国 NETZSCH/耐驰公司的同步热分析仪 NETZSCH STA449 F3,在空气氛围中从 40℃升到 1450℃,升温速 度为 7℃/min。

#### 3. 结果与讨论

图 2 是掺杂不同含量 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的 Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 陶瓷在 1450℃烧结,保温 3 h 下的密度变化,如图所示,随着 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的含量升高,样品的密度不断增大,当 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的添加量为 20 wt.% (S3)时,密度最高为 2.68 g·cm<sup>-3</sup>。 在 0 wt.%~15 wt.%的添加量下样品密度增大最为明显,S3 密度增加较为缓慢的原因是过多的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 添加 导致 Al<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>(Al-Si-O)复合相含量增多,而 Al<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>(Al-Si-O)复合相的密度略低于 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,后续 XRD 物相 检测也能证明这一点。图 3 为不同烧结温度下 S2 和 S3 密度的变化,从图中可看出,S3 的密度均大于 S2,其中 S3 最大密度为 2.68 g·cm<sup>-3</sup>,S2 最大密度为 2.63 g·cm<sup>-3</sup>,并且都在 1450℃烧结下获得密度最大 值。从整体来看,在 1350℃~1450℃范围内随着烧结温度的升高,Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 陶瓷密度也不断增加,因此在 此温度范围内,温度升高有利于烧结助剂形成更多的液相包裹 Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O,从而提高 Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 陶瓷的致密度, 但到了 1480℃样品的密度反而减小,其原因在于常压烧结下 Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 出现较为明显的分解现象[14] [15]。 如图 4 所示,为未添加烧结助剂的 Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 陶瓷粉末在 1400℃进行热重分析。从图中可以看出样品在 1400℃ 就有 3.83%的重量损失,这和 Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 自身的分解有关,当温度继续升高,样品失重加速,最终在 1480℃ 时样品失重率达到顶点。









图 3. 不同温度下 S2、S3 的密度变化





从 XRD 分析(图 5)可以看出: Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 作为烧结助剂会使得部分 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 会与部分 Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 发生反应,生成少量 Al<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>(Al-Si-O)复合相,随着 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的含量增加,从而使得 Al<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub> 相的峰值强度变大,而 Al<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub> 的密度仅为 2.9 (g·cm<sup>-3</sup>)低于 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的密度,与 Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 密度接近,所以导致 S2 到 S3 的密度增加量,小于 S1 到 S2 的密度增加量。



**Figure 5.** Diffraction patterns of different Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> contents at 1450°C 图 5. 1450°℃下,不同 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 含量的衍射图谱

图 6 为不同 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 含量的样品在 1450℃烧结之后的扫描电镜图片,如图所示,随着 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的含量增加,能明显看出样品内部的孔隙越来越少,微观结构更加紧凑,其中 S2、S3 有明显的液相烧结痕迹,而液相越多越能包裹住更多的 Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 颗粒,因此 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 有助于 Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 样品的密度提高。图 7 为 S2、S3 在 不同烧结温度下的电镜图片,可以看出当温度升到 1480℃时,两组样品孔隙均有增加,相比于 1450℃有 更多的锯齿颗粒感,且同时出现柱状晶体结构,而 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 晶体大多为柱状晶体,同时 Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 陶瓷在氮气 氛围和高温条件下通常分解为 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 和 SiO<sub>2</sub> [14],因此 Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 陶瓷在 1480℃下的常压烧结 Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 陶瓷 更易出现分解现象。



**Figure 6.** SEM images of different Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> contents at 1450°C (a) S0, (b) S1, (c) S2, (d) S3 图 6. 1450°℃下,不同 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 含量的 SEM 图(a) S0, (b) S1, (c) S2, (d) S3



**Figure 7.** SEM images at different sintering temperatures (a) 1450°C, S2, (b) 1450°C, S3, (c) 1480°C, S2, (d) 1480°C, S3 图 7. 不同烧结温度下的 SEM 图(a) 1450°C, S2, (b) 1450°C, S3, (c) 1480°C, S2, (d)

## 4. 结论

1) Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 会与 Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 发生反应,其剧烈程度与温度和添加量成正相关,当烧结温度为 1450℃时形成 的液相最多的同时也分布较为平均。

2) Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的添加有助于 Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 样品的密度提高,当添加量为 15 wt.%时样品密度提升最为明显,添加 量增加到 20wt.%后样品密度虽有所提升,但同时也加剧了与 Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 的反应,导致副产物增加,因此为了 更好地体现 Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 陶瓷的性能, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的添加量应控制在 15 wt.%。

3) Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 陶瓷在常压氮气氛围烧结下,添加 15 wt.%及以上的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 助剂,随着烧结温度升高有利于 形成更多的液相包裹 Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 来提升其致密度,但过高的烧结温度会使得 Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 发生分解并形成更多的 孔隙,从而降低其综合性能,因此烧结温度控制在 1450℃为最佳。

## 参考文献

- Yang, H., Li, Y., Li, Q., Wang, Z., Wu, H., Liu, X., *et al.* (2020) Preparation and Properties of Porous Silicon Nitride Ceramics with Polymethyl Methacrylate as Pore-Forming Agent. *Ceramics International*, 46, 17122-17129. <u>https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.03.204</u>
- [2] Geng, Y., Zhao, Y., Yue, F., Zhu, Q. and Xiang, M. (2022) A Novel Method to Synthesize Pure-Phase Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O Powders in a Fluidized Bed Reactor. *Ceramics International*, 48, 33066-33071. <u>https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.07.239</u>
- [3] 蔡德龙,陈斐,何凤梅,等. 高温透波陶瓷材料研究进展[J]. 现代技术陶瓷, 2019, 40(1): 4-120.
- [4] Fan, B., Li, W., Zhang, F., Li, H., Zhang, R., Liu, G., et al. (2020) Fabrication and Properties of Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O Ceramics for Microwave Sintering Furnace. Processing and Application of Ceramics, 14, 32-39. <u>https://doi.org/10.2298/pac2001032f</u>
- [5] Brosset, C. and Idrestedt, I. (1964) Crystal Structure of Silicon Oxynitride, Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O. *Nature*, **201**, 1211-1211. <u>https://doi.org/10.1038/2011211a0</u>
- [6] 文晋. 高温氮化合成 Si2N2O 及其对耐火材料性能的优化研究[D]: [硕士学位论文]. 武汉: 武汉科技大学, 2015.
- [7] Ohashi, M., Tabata, H. and Kanzaki, S. (1988) High-Temperature Flexural Strength of Hot-Pressed Silicon Oxynitride Ceramics. *Journal of Materials Science Letters*, 7, 339-340. <u>https://doi.org/10.1007/bf01730734</u>
- [8] Ohashi, M., Kanzaki, S. and Tabata, H. (1991) Effect of Additives on Some Properties of Silicon Oxynitride Ceramics. *Journal of Materials Science*, **26**, 2608-2614. <u>https://doi.org/10.1007/bf00545544</u>
- [9] Larker, R. (1992) Reaction Sintering and Properties of Silicon Oxynitride Densified by Hot Isostatic Pressing. *Journal of the American Ceramic Society*, **75**, 62-66. <u>https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1992.tb05442.x</u>
- [10] Rezazadeh, M., Emadi, R., Saatchi, A., et al. (2019) In-Situ Reactive Synthesis of Full Dense Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O by Incorporating of Amourphous Nanosized Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>; Effect of MgO and Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Journal of Nanostructures, 9, 131-140.
- [11] 高梅, 李勇, 秦海霞, 等. 闪速燃烧合成氮化硅铁的氮化机理[J]. 硅酸盐学报, 2015, 43(3): 358-362.
- [12] Sévin, L., Lochet, N. and Beaudet-Savignat, S. (2024) Influence of Sintering Aids on Properties of Dense Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O Ceramic Developed by Spark Plasma Sintering. *Journal of the European Ceramic Society*, 44, 193-204. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2023.08.049
- [13] 杜姣龙. Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O 基透波陶瓷材料的制备及性能研究[D]: [硕士学位论文]. 郑州:郑州大学, 2019.
- [14] Huang, Z.K., Greil, P. and Petzow, G. (1984) Formation of Silicon Oxinitride from Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> and SiO<sub>2</sub> in the Presence of

<sup>1480°</sup>C, S3

Al2O3. Ceramics International, 10, 14-17. https://doi.org/10.1016/0272-8842(84)90017-8

[15] Li, W., Zhang, F., Li, N., Su, T., Fan, B., Li, H., et al. (2018) Effect of Atmosphere on the Fabrication of Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O Matrix Composites. Processing and Application of Ceramics, **12**, 66-71. <u>https://doi.org/10.2298/pac18010661</u>